

мерных атомных решётках, выявлять поверхностный магнетизм, поверхностнуюмагн. анизотропию. Прямое и косвенное обменное взаимодействие электронов изучается на специально приготовленных пленках с «модулированной» атомной структурой (система чередующихсямагн. и немагн. слоёв толщиной в один или неск. нанометров).

Эксперименты показали, что заметное уменьшение M_s наступает лишь в М. п. толщиной менее десятка атомных слоёв (<3 нм) и у этих же пленок обнаруживается нек-рое снижение темп-ры Кюри. В области низких темп-р T наблюдается переход от известного *Блоха закона* $\Delta M_s \sim T^{3/2}$, выполняющегося для толстых ферромагн. пленок, к почти линейному спаду намагниченности с темп-рой в сверхтонких М. п. Правда, такие «олигатомные» пленки чаще всего уже не являются однородными, а имеют островковую структуру.

Спонтанная намагниченность M_s М. п. определяется не только хим. составом, но и фазовым состоянием конденсата, зависящим от условий осаждения.

Фундам. свойством М. п. является *магнитная анизотропия*, характеризуемая типом симметрии, ориентацией осей лёгкого намагничивания, энергетич. константами или напряжённостью H_A эффективного поля анизотропии. Наряду с магнитостатич. анизотропией формы и естеств. кристаллографич.магн. анизотропией в монокристаллич. М. п., в текстурированных поликристаллич. пленках (Со, MnBi и др.) может существовать значит. плавёчная анизотропия разл. природы: магнитоуругая (магнитострикционная) анизотропия; анизотропия направленногоупорядочения атомов, осуществляющегося в процессе роста и термообработки М. п.; анизотропия направленного роста зёрен; ориентация вытянутых пор; анизотропия распределениямагн. и немагн. примесей по границам зёрен и др. При осаждении пленок после термич. испарения в вакууме в М. п. возникает анизотропия, вызванная наклонным падением атомов на подложку с образованием цепочек кристаллитов (механизм самозатечения), с наклонной столбчатой структурой. При эпитаксиальном росте М. п. из жидкой фазы со сложным ионным составом, напр. пленок редкоземельных ферритов-гранатов, возникает ростовая анизотропия, обусловленная избират. осаждением разл. ионов в «открытые» додекаэдрич. позиции определённой плоскости роста.

Результирующая анизотропия определяет тип *магнитной доменной структуры* и характер процессов намагничивания М. п. В пленках с преобладающей анизотропией формы (фактор качества $Q < 1$) спонтанная намагниченность лежит в плоскости образца, и в этом случае образуются вытянутые т. н. плоскиемагн. домены (ПМД). Оси. процессом *перемагничивания* таких М. п. вдоль оси лёгкого намагничивания является движение *доменных стенок*, наблюдается прямоугольная петля гистерезиса с коэрцитивной силой H_c , равной полю старта необратимого смещения стенок (границ).

В пленках с преобладающей перпендикулярной анизотропией (фактор качества $Q > 1$) ось лёгкого намагничивания (ОЛН) ориентирована по нормали к поверхности. В таких М. п. образуются круглые *цилиндрические магнитные домены* (ЦМД), и плотная полосовая или лабиринтная доменная структура. В чистых, практически бездефектных пленках петля гистерезиса очень узкая ($H_c \lesssim 1$ А/см) и наклонённая. В определённом интервале значений внеш. поля H , приложенного вдоль ОЛН, наблюдаются равновесные ЦМД, к-рые легко передвигаются по пленке под действием неоднородного поля. Эти подвижные ЦМД в феррит-гранатовых М. п. используются в качестве носителей информации вмагн. запоминающих устройствах (ЗУ).

К концу 1980-х годов достигнут значит. прогресс в эксперим. и теоретич. исследованиях М. п.— ихмагн. микроструктуры, статики и динамики доменной структуры и структуры между доменными стенками. Обнаружено

сильное влияние тонкой структуры степок («скрученности», наличия в них т. н. *Блоха линий* и *Блоха точек*) на их поведение в импульсном и высокочастотноммагн. поле. Присутствие линий Блоха, разделяющих разнополярные участки стенки, во-первых, заметно снижает подвижность стенки из-за доополнит. рассеяния эл.-магн. энергии, а во-вторых, вызывает рост эффективной массы «жёсткой» стенки вследствие накопления кинетич. энергии в линиях Блоха, перемещающихся вдоль движущейся стенки (см. *Доменной стенки динамика*). Разрабатываются запоминающие устройства со сверхвысокой плотностью записанной информации, в к-рых вбитом является пара вертикальных линий Блоха, пребывающая вдоль замкнутой стенки полосового домена в феррит-гранатовых пленках.

Тонкие М. п. нашли широкое применение в вычислите. технике и автоматике, в оптоэлектронике и интегр. оптике. На базе М. п. возникла новая отрасль науки и техники —магн. микроэлектроника. Пленочная (интегральная) технология позволяет решать актуальные задачи микроминиатюризации элементной базы и схемотехники ЭВМ.

М. п. пришли на смену таких дискретныхмагн. элементов логич. и запоминающих устройств, как ферритовые сердечники, трансфлюкторы и пластины с отверстиями. Вместо них было предложено использовать матрицы из пермалловых пятец толщиной ~ 100 нм или цилиндрич. М. п. (бронзовые проволоки, покрытые слоем пермаллоя толщиной ок. 1 мкм) с колышевыми замкнутыми по окружностимагн. доменами.

Созданы т. н. доменные ЗУ, в к-рых элементом памяти являетсямагн. домен с определённой поляризацией спонтанной намагниченности. К ним относятся: устройства на *плоских Магн. доменах*, *продвигающихся в низкоэрцитивных каналах*; ЗУ на подвижных ЦМД диаметром ок. 1 мкм, на решётках ЦМД. Помимо записи, продвижения, хранения и считывания цифровой информации доменные устройства на М. п. обеспечивают производство осн. логич. операций (т. е. обработку информации). Твердотельные ЗУ на ЦМД обладают высокой надёжностью, компактностью, энергонезависимостью и малой чувствительностью к неблагоприятным внешн. воздействиям. Огромная информац. плотность и ёмкость ЦМД-микросхем делает их конкурентоспособными с ЗУ намагн. дисках и барабанах.

Др. перспективное направление развития информационно-вычисл. систем состоит в разработке магнитооптич. памяти на М. п. (магнитооптич. диски). Это направление предполагает использование лазеров, записи информации термомагн. способом, а считывание — с помощью магнитооптич. эффектов Керра или Фарадея. В качестве реверсивной среды — носителя информации служат М. п. из соединений типа TR (T — переходный металл, R — редкоземельный элемент), обеспечивающие высокую плотность записи ($\sim 10^7$ бит/см²) и надёжное магнитооптич. считывание. Пленки с высокой магнитооптич. добротностью (напр., В1-содержащие феррит-гранатовые пленки) используются в оптич. дефлекторах и модуляторах, вентильных и переключательных устройствах волоконно-оптич. линий связи.

Магнитно-мягкие (пермалловые) пленки используются при создании магнитопроводов, полюсных наконечников с узким зазором в многоканальных интегр.магн. головках для записи и индукц. считывания информации, для магниторезистивного считывания.

В СВЧ-технике М. п. применяются в виде фильтров поглощения и пропускания, фазовращателей и вентилей в интегр. исполнении. В этих устройствах используются такие явления, как ферромагн. резонанс, спин-волновые эффекты и магнитоакустич. колебания.

Лит.: Тонкие ферромагнитные пленки, пер. с нем., М., 1964; Физика тонких пленок, пер. с англ., т. 1—8, М., 1967—78; Суху Р., Магнитные тонкие пленки, пер. с англ., М., 1967; Колотов О. С., Погожев В. А., Телесенин Р. В., Методы и аппаратура для исследования импульсных свойств тонких магнитных пленок, М., 1970; Ильюшин-